

ESTUDIO DEL TIEMPO DE RECUPERACION INVERSA EN DIODOS SEMICONDUCTORES

Martin P. Puertaz¹, Simon A. Gudziak² Victor H. Kurtz^{3(*)}

Universidad Nacional de Misiones – Facultad de Ingeniería

¹martinpuertaz@hotmail.com; ²gudziak5@hotmail.com; ³kurtzvh@gmail.com

Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Carrera de Ing. Electrónica
Dpto. de Electrónica. Proyecto de investigación: 16/1091

Modalidad: Poster Director: Mgter. Ing. Víctor H. Kurtz

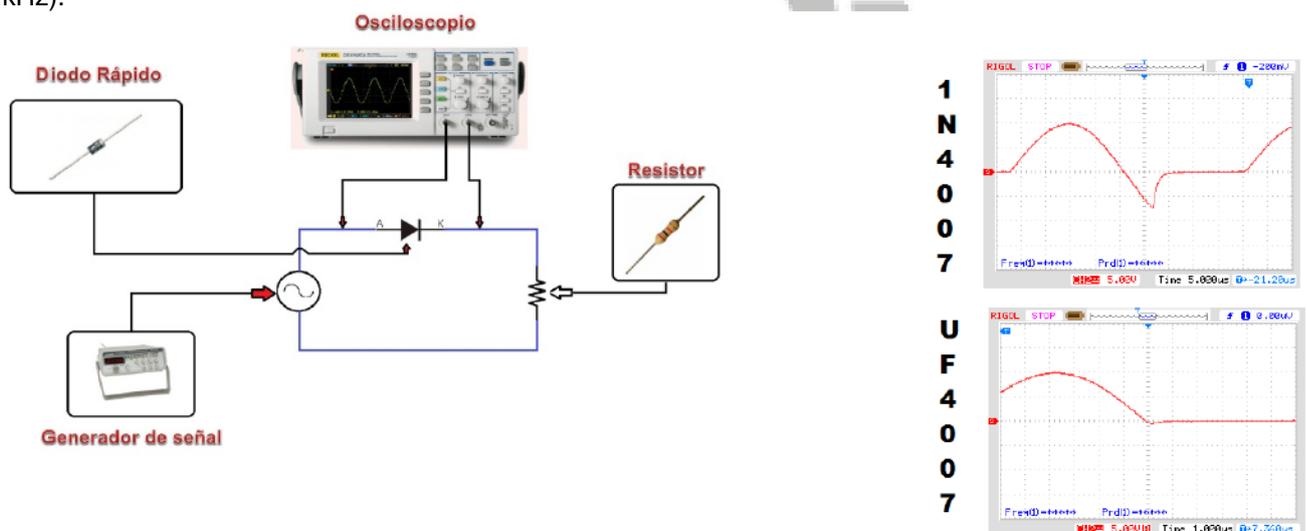
RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados del ensayo de diodos rectificadores a frecuencias superiores a las industriales.

Se analizan diodos semiconductores estándares y diodos denominados rápidos.

Confrontando ambos resultados.

La implementación de convertidores para la regulación y control de la microgeneración eléctrica, conforme a los lineamientos del proyecto de investigación 16/1091. Se hace indispensable en uso de componentes electrónicos (por ej. Diodos rectificadores) que trabajen a frecuencia relativamente elevadas (del orden de los kHz).



PALABRAS CLAVES: Diodos Rápidos. Tiempo de Recuperación. Rectificación. Conmutación. Dispositivos Electrónicos.

(*)Plantel docente de la asignatura Dispositivos Electrónicos: Jorge A. Olsson, Germán A. Xander y Luis A. Mund.